



# 桂林斯壯微電子有限責任公司

## Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

GMBAS70

### SCHOTTKY DIODE 肖特基二極管(BAS70)

#### ■FEATURES 特點

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Power dissipation 耗散功率	$P_D(T_a=25^\circ\text{C})$	225	mW
Forward Current 正向電流	$I_F$	70	mA
Reverse Voltage 反向電壓	$V_R$	70	V
Junction and Storage Temperature 結溫和儲藏溫度	$T_J, T_{stg}$	-55to+150°C	

#### ■DEVICE MARKING 打標

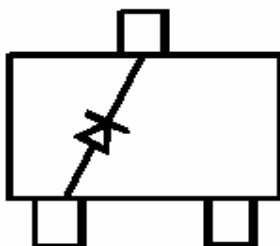
**BAS70=BE**

#### ■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Reverse Breakdown Voltage 反向擊穿電壓 ( $I_R=10\mu\text{A}$ )	$V_{(BR)}$	70	—	V
Reverse Leakage Current 反向漏電流 ( $V_R=50\text{V}$ ) ( $V_R=70\text{V}$ )	$I_R$	—	0.1 10	$\mu\text{A}$
Forward Voltage(Test Condition)正向電壓 $I_F=1\text{mA}_{dc}$ $I_F=10\text{mA}_{dc}$ $I_F=15\text{mA}_{dc}$	$V_F$	—	410 750 1000	mV
Diode Capacitance 二極體電容 ( $V_R=1\text{V}$ , $f=1\text{MHz}$ )	$C_D$	—	2	pF
Reverse Recovery Time 反向恢復時間	$T_{rr}$	—	5	nS

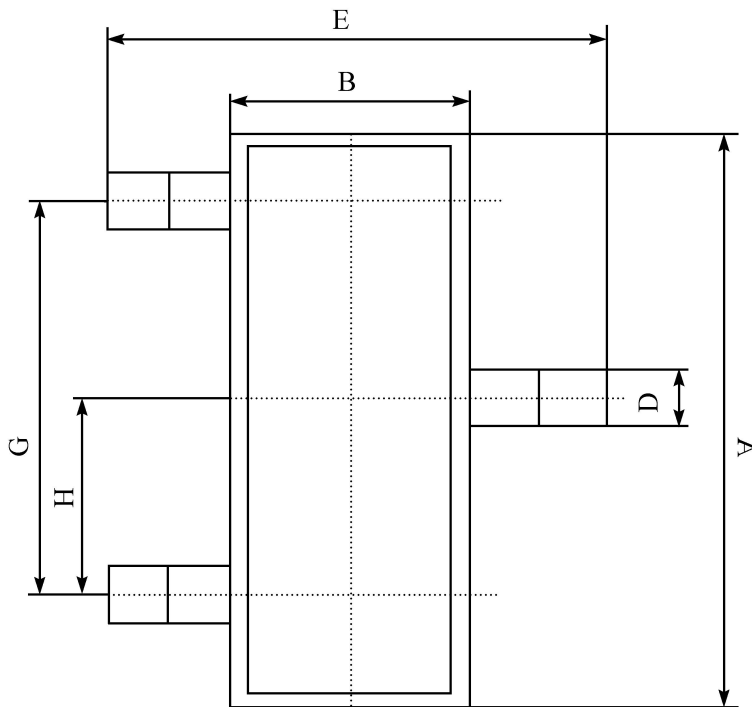
#### ■SOT-23 内部结构





GMBAS70

■DIMENSION 外形封裝尺寸



序號	數值及公差
A	$2.90 \pm 0.10$
B	$1.30 \pm 0.10$
C	$1.00 \pm 0.10$
D	$0.40 \pm 0.10$
E	$2.40 \pm 0.20$
G	$1.90 \pm 0.10$
H	$0.95 \pm 0.05$
J	$0.13 \pm 0.05$
K	$0.00 - 0.10$
M	$\geq 0.2$
N	$0.60 \pm 0.10$
P	$7 \pm 2^\circ$

